

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
【部門区分】第 7 部門第 2 区分
【発行日】令和 6 年 3 月 15 日(2024.3.15)

【公開番号】特開 2022-139255(P2022-139255A)
【公開日】令和 4 年 9 月 26 日(2022.9.26)
【年通号数】公開公報(特許)2022-176
【出願番号】特願 2021-39546(P2021-39546)
【国際特許分類】

H 0 1 L 21/304(2006.01)
B 2 4 B 1/04(2006.01)
B 2 4 B 9/00(2006.01)
B 2 4 B 7/22(2006.01)
B 2 4 B 53/12(2006.01)
B 2 4 B 53/04(2012.01)
B 2 4 B 49/12(2006.01)

10

【F I】

H 0 1 L 21/304 6 2 1 E
B 2 4 B 1/04 C
B 2 4 B 9/00 6 0 1 H
B 2 4 B 7/22 Z
B 2 4 B 53/12 Z
B 2 4 B 53/04
B 2 4 B 49/12

20

【手続補正書】
【提出日】令和 6 年 3 月 6 日(2024.3.6)
【手続補正 1】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】0 0 2 7
【補正方法】変更
【補正の内容】

30

【0 0 2 7】

【図 1】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置を示す平面図である。

【図 2】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置のエッジトリミング装置を示す正面図である。

【図 3】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置のエッジトリミング装置を示す平面図である。

【図 4】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造装置の撮像装置の画像データを示す図である。

40

【図 5】本発明の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であり、図 5 (a) は、チャッキング工程で半導体デバイスウェーハが準備される状態、図 5 (b) は、エッジトリミング工程でトリミングが行われている状態、図 5 (c) は、エッジトリミング工程が完了した状態、図 5 (d) は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【図 6】本発明の実施形態に係るトリミング面の近傍を示す図であり、図 6 (a) は、エッジトリミング工程が完了した状態、図 6 (b) は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【図 7】本発明の他の実施形態に係る半導体装置の製造方法を示す図であり、図 7 (a) は、チャッキング工程で半導体デバイスウェーハが準備される状態、図 7 (b) は、エッジトリミング工程でトリミングが行われている状態、図 7 (c) は、エッジトリミング工

50

程が完了した状態、図 7 (d) は、薄層化工程で薄層化が行われた状態を示す図である。

【 手 続 補 正 2 】

【 補 正 対 象 書 類 名 】 図 面

【 補 正 対 象 項 目 名 】 図 5

【 補 正 方 法 】 変 更

【 補 正 の 内 容 】

【 図 5 】

